## ITOに固定化した可溶性SWNT単層膜の電気化学的特性

(東邦大理) ○森山広思 王 奇観

【序】 SWNT の電子材料への応用は、高分散化(可溶化)がきわめて重要な要件である。その ためには SWNT 官能基化が必須であるが、さらに SWNT 本来の特性を保持しつつ化学結合によっ て基板修飾を図る方法が有望なアプローチのひとつとなる。今回、ITO 表面水酸基を 3-アミノプ ロピルトリメトキシシランによって修飾し、2 段階酸化官能基化によって得られた SWNT のカル ボキシル基と間でアミド結合を生成させて ITO-SWNT 薄膜を得た。XPS、SEM によって同定し、 さらにこの薄膜に関して電気化学的特性を調べた。





【実験】 マイクロ波照射下、SWNT を  $H_2O_2$  と混酸(1:1  $H_2SO_4/HNO_3$  (v/v))による 2 段階酸化官 能基化を行い、透析膜を用いて中性にし、SWNT-(COOH)<sub>m</sub>を得た。アニリン4量体は文献の方法 <sup>1)</sup> によりロイコ体として得、FTIR, UV-vis, NMR により同定した。ITO 基板 (10 $\Omega/\Box$ , EHC Co. Ltd) は定法により表面清浄化した後、表面修飾を行い、DCC 法によって SWNT-(COOH)<sub>m</sub> とアミド結 合により反応させた。電気化学測定は BAS 社の ALS/CHI600A 電気化学アナライザーを用いた。

【結果と考察】 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> と混酸(1:1 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/HNO<sub>3</sub> (v/v))による2段階酸化官能基化によって、カルボ キシル基(-COOH)とスルホン酸基(-SO<sub>2</sub>OH)を含む、高圧下マイクロ波照射<sup>2)</sup>によって得られたも のと同様の官能基化 SWNT が得られた。この官能基化 SWNT は修飾 ITO とのアミド化によって ITO 表面に固定化することができ、さらにアニリン4量体を反応させてスキームに示した薄膜を得た。

Fig. 1に、アニリン4量体および SAM-ITO 薄膜の UV-vis スペクトルを示す。アニリン4量体は、565 nm に 特徴的な弱いポーラロン吸収が観測されるが、このピー クは SWNT と化学結合することによって 25 nm 長波長側 にシフトし 590 nm に観測される。このことはアニリン4 量体が、官能基化された SWNT と何らかの電荷移動的な 相互作用をしていることを示唆する。

官能基化 SWNT が、修飾 ITO のアミノ基を介して 固定化されたことは電気化学的測定から明瞭であり、 Fig. 2 から SWNT の導入によって電気化学的に活性 な薄膜が生成していることがわかる。

1.0 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 中での酸化還元挙動は、Fig. 3 に示す ように SWNT SAM-ITO とアニリン4量体でエンドキ ャップした SWNT SAM-ITO とでは、大きく異なる。 前者では、おもに SWNT のレドックスに由来する



Fig. 1. UV–vis spectra of: tetramer aniline emeraldine in (a) DMF; and (b) SWNT functionalized ITO end-capped by tetramer aniline groups.

0.42 V, 0.56 V に酸化波、0.24 V で還元波が観測されるのに対して、後者では 0.50 V と 0.4 V に アニリン4 量体の leucoemeraldine タイプと emeraldine タイプ間の可逆的酸化還元に対応した ピークが観測された。アニリン4 量体でエンドキャップすることによって、電気化学的安定な SWNT 薄膜を生成することが可能となった。





Fig. 2 Cyclic voltammograms of bare ITO, APTMS-modified ITO (APTMS–ITO) and SWNT-functionalized ITO (SAM–ITO) in  $CH_3CN$  with 0.1 M TBAP as the supporting electrolyte. Scan rate = 0.05 V/s.

Fig. 3 CV traces of: (a) SWNT SAM–ITO and (b) SWNT SAM–ITO end-capped by tetramer aniline groups in an aqueous 1.0 M  $H_2SO_4$  solution. Scan rate = 0.05 V/s.

【参考文献】

1) Zhang, W. J.; Feng, J.; MacDiarmid, A. G.; Epstein, A. J. Synth. Metals **1997**, 84, 119–120. 2) Wang, Y. B.; Iqbal, Z.; Mitra, S. J. Am. Chem. Soc. **2006**, *128*, 95–99.